

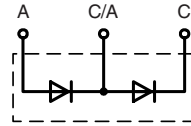
Power Schottky Rectifier dual diode

$$I_{FAV} = 2 \times 30 \text{ A}$$

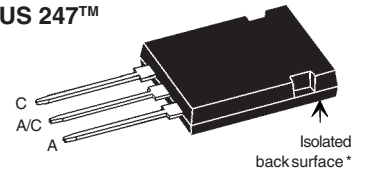
$$V_{RRM} = 100 \text{ V}$$

$$V_F = 0.63 \text{ V}$$

V_{RSM}	V_{RRM}	Type
V	V	
100	100	DSSS 30-01AR



ISOPLUS 247™



C = Cathode, A = Anode

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I_{FRMS}		70	A
I_{FAV}	$T_C = 155^\circ\text{C}$; rectangular, $d = 0.5$	30	A
I_{FAV}	$T_C = 155^\circ\text{C}$; rectangular, $d = 0.5$; per device	60	A
I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$; $t_p = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	600	A
E_{AS}	$I_{AS} = 15 \text{ A}$; $L = 100 \mu\text{H}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$; non repetitive	11.3	mJ
I_{AR}	$V_A = 1.5 \cdot V_{RRM}$ typ.; $f = 10 \text{ kHz}$; repetitive	1.5	A
$(dv/dt)_{cr}$		5000	V/ μs
T_{VJ}		-55...+175	$^\circ\text{C}$
T_{VJM}		175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55...+150	$^\circ\text{C}$
P_{tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	190	W
F_C	mounting force with clip	20...120	N
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS; $t = 1 \text{ s}$	3000	V~
Weight	typical	6	g

Features

- International standard package
- Very low V_F
- Extremely low switching losses
- Low I_{RM} -values
- Isolated and UL registered E153432

Applications

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

Advantages

- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses

Dimensions see Outlines.pdf

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_R ①	$V_R = V_{RRM}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	2 20	mA mA
V_F	$I_F = 30 \text{ A}$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $I_F = 30 \text{ A}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 60 \text{ A}$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	0.63 0.79 0.78	V V V
R_{thJC} R_{thCH}	0.25	0.8	K/W K/W

Pulse test: ① Pulse Width = 5 ms, Duty Cycle < 2.0%
Data according to IEC 60747 and per diode unless otherwise specified

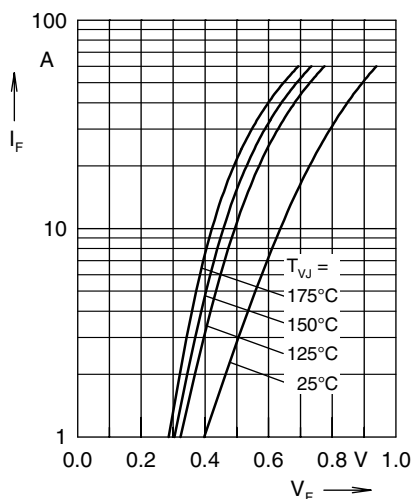


Fig. 1 Max. forward voltage drop characteristics

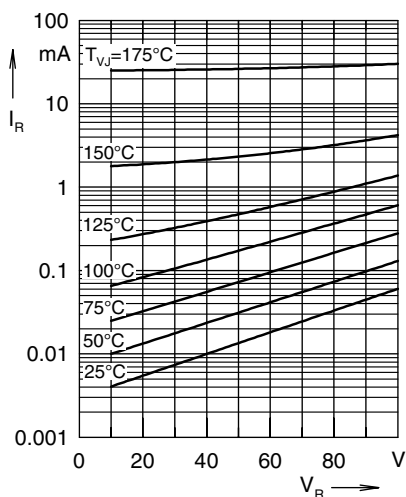


Fig. 2 Typ. reverse current I_R versus reverse voltage

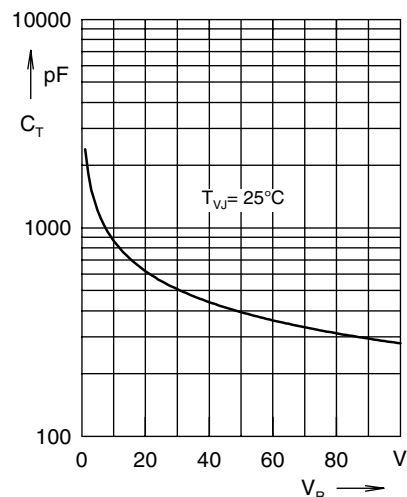


Fig. 3 Typ. junction capacitance C_T vs. reverse voltage V_R

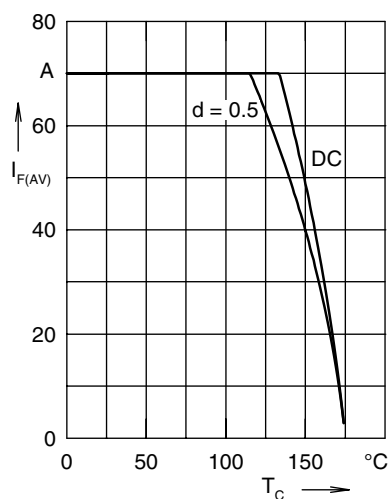


Fig. 4 Avg. forward current $I_{F(AV)}$ vs. case temperature T_C

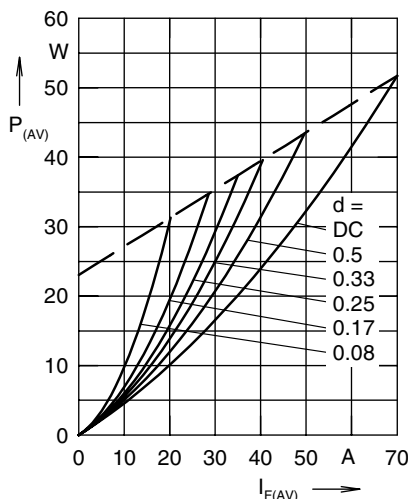


Fig. 5 Forward power loss characteristics

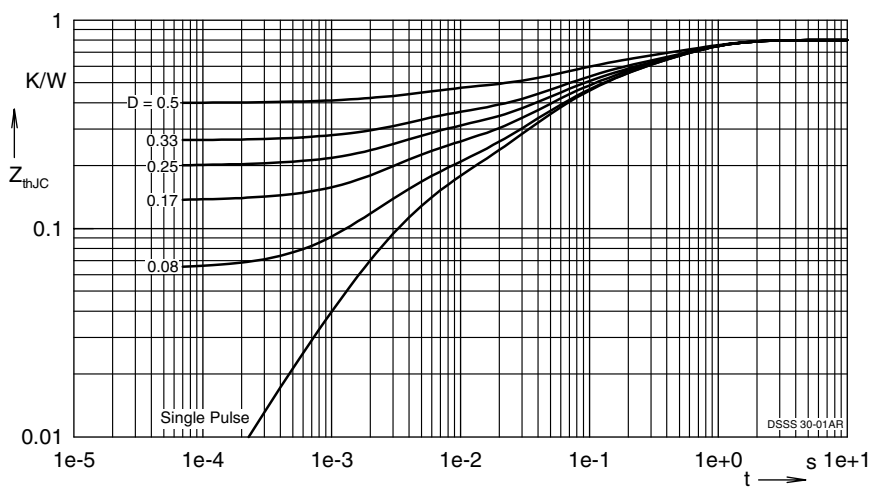


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case at various duty cycles

Note: All curves are per diode

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9